



中科海高
HiGaAs Microwave

V1.2

HGC181-1B

GaAs MMIC
限幅器, 2 - 18 GHz

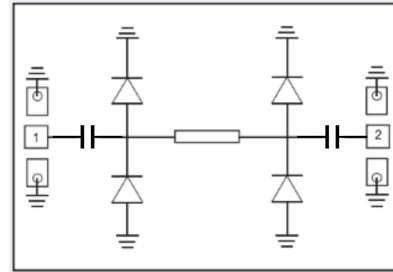
12

限幅器
|
裸芯片

主要特点

频段: 2 - 18 GHz
插入损耗: 0.5 dB
限幅电平: 16 dBm
回波损耗: 20 dB
耐功率: 3W (CW)
芯片尺寸: 1.38×0.92×0.1 mm³

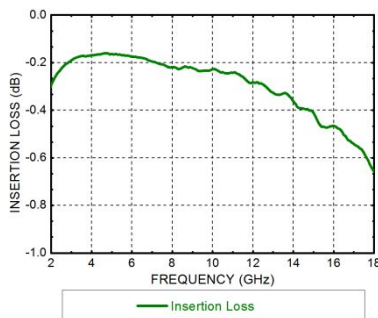
功能框图



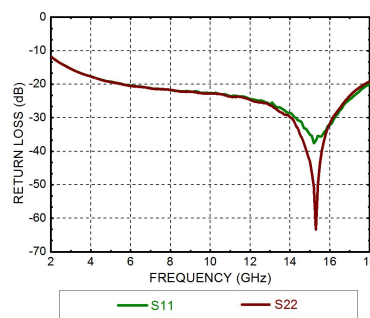
性能指标 ($T_A = +25^\circ\text{C}$)

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	2 - 18			GHz
插入损耗		0.5		dB
回波损耗		20		dB
限幅电平		16		dBm

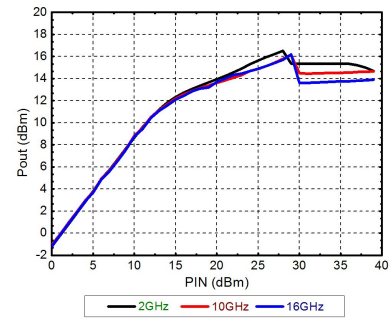
插入损耗



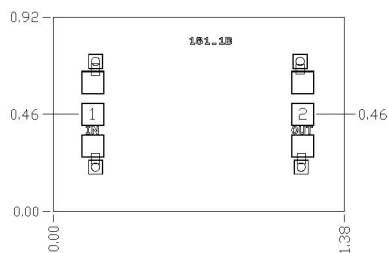
回波损耗



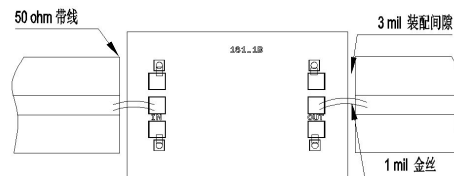
限幅电平



物理参数



装配图



注意事项

- 1、芯片背面镀金
- 2、芯片背面需接地
- 3、推荐共晶烧结工艺安装芯片
- 4、键合焊盘金属化: 金
- 5、键合焊盘尺寸为 100*100 μm^2
- 6、外形尺寸公差: $\pm 50 \mu\text{m}$
- 7、本产品采用空气桥工艺, 表面不带钝化层

焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1	IN	输入端口, 阻抗 50 Ohm, 有隔直电容
2	OUT	输出端口, 阻抗 50 Ohm, 有隔直电容
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地

极限参数

最大输入功率	3W, 25° C
存储温度	-65~+150° C
工作温度	-55~+85° C